

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* мало-
мощные

Предназначены для работы в усилительных и импульсных
микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами
в двух вариантах

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,3 г

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	45 В
КТ209Л, КТ209М	60 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	40 В
КТ209Л, КТ209М	55 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10$ кОм

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	45 В
КТ209Л, КТ209М	60 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	40 В
КТ209Л, КТ209М	55 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	20 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	15 В

Постоянный ток коллектора 300 мА

Импульсный ток коллектора 500 мА

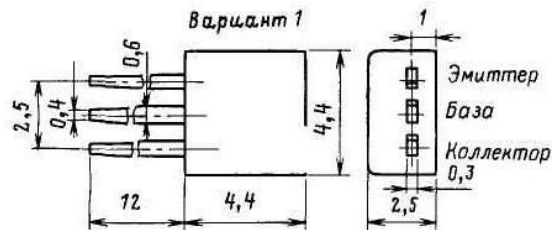
Постоянный ток базы 100 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 200 мВт

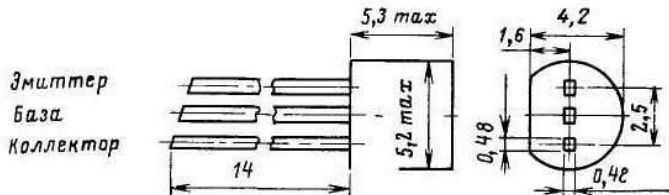
Тепловое сопротивление переход-среда 0,45 К/мВт

Температура перехода 398 К

Температура окружающей среды От 228
до 373 К



Вариант 2



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_K = 10$ мА не менее	5 МГц
Коэффициент шума при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 0,2$ мА, $f = 1$ кГц, $R_T = 3$ кОм КТ209В, КТ209Е, КТ209К не более	5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_K = 30$ мА	
при $T = 298$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л	20-60
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М	40-120
КТ209В, КТ209Е	80-240
КТ209К	80-160
при $T = 373$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л	20-120
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М	40-240
КТ209В, КТ209Е	80-480
КТ209К	80-320
при $T = 228$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л	10-60
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М	20-120
КТ209В, КТ209Е	40-240
КТ209К	40-160
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более	0,4 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более	1,5 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 500$ кГц не более	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 1$ МГц не более	100 пФ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 5$ мА	130-2500 Ом
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = U_{ЭБ\max}$ не более	1 мкА